最　高　行　政　法　院　判　決

110年度上字第397號

上　訴　人　頎邦科技股份有限公司

代　表　人　吳非艱
訴訟代理人　李宗德　律師
　　蔡毓貞　律師
　　劉昱劭　律師
複 代理 人　施志寬　律師
上　訴　人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
被 上訴 人　易華電子股份有限公司

代　表　人　黃嘉能
訴訟代理人　黃耀霆　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年3月4日智慧財產法院109年度行專訴字第38號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人頎邦科技股份有限公司負擔。

理　由

一、事實概要：緣上訴人頎邦科技股份有限公司（下稱頎邦公司）前於民國105年3月17日以「線路基板圖案化製程及線路基板」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，申請專利範圍共15項，經上訴人智慧局編為第105108350號審查號審查後，於106年6月13日核准專利，並於106年8月11日公告發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於108年1月30日以系爭專利違反專利法第

26條第1項及第22條第2項規定，對之提起舉發。案經上訴人智慧局審查，以108年12月19日（108）智專三（一）04273字第10821207370號專利舉發審定書為「請求項1、8至10舉發成立，應予撤銷」、「請求項2至7、11至15舉發不成立」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，就原處分關於舉發不成立部分，循序提起行政訴訟，並聲明：㈠訴願決定及原處分關於「請求項2至7、11至15舉發不成立」部分均撤銷。㈡命上訴人智慧局就系爭專利為「請求項2至7、11至15舉發成立，應予撤銷」之處分，嗣經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）109年度行專訴字第38號行政判決（下稱原判決）撤銷訴願決定及原處分關於「請求項2至5、11至13舉發不成立」部分、上訴人智慧局應就系爭專利為「請求項2至5、11至13舉發成立，應予撤銷」之處分，並駁回被上訴人其餘之訴。上訴人頎邦公司就不利其部分不服，提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，為上訴人不利判決，係以：㈠證據1與系爭專利請求項2相較，二者差異為：1.證據1係以光阻為遮罩進行圖案化金屬層、金屬化層後，再移除光阻，而系爭專利請求項2係以光阻為遮罩進行圖案化線路層後，即移除光阻層，以線路層為遮罩進行圖案化結合層，二者步驟順序有差異。2.證據1並未揭露系爭專利請求項2「其中各該第一承載部具有一第一外環面，各該第二承載部具有一第二外環面，該第二外環面與沿著該第一外環面的一縱向延伸線之間形成一側蝕槽，該側蝕槽位於該第一承載部下方且連通該第三槽，該第二外環面與該縱向延伸線之間具有一第一水平距離」之附屬技術特徵。此外，證據1雖揭露於聚醯亞胺膜形成金屬化層之際，在產生聚醯亞胺膜之表面上造成表面變質層2，惟證據1並未直接揭露聚醯亞胺底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層之技術特

徵，故亦未直接揭露「部份的該結合層嵌入該活化層中，使得嵌有該結合層的該活化層形成為一混合層」及「該第二槽顯露該混合層……移除被該些第二槽顯露的該混合層，使位於該些第一承載部下方的該混合層形成複數個第二承載部」之技術特徵。㈡證據1、8與通常知識1、2之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性；證據1、2、8之組合、證據1、5、8與通常知識2之組合或證據1、2、5、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。依證據1說明書第5頁第3至5行及證據8說明書第0001段內容所示，證據1、8均屬於半導體封裝用軟性電路板之技術領域，具有技術領域之關聯性，另依證據1說明書第6頁第12至13行及證據8說明書第0031段內容所示，證據1、8均係為解決微細線路基板之絕緣可靠性問題，所欲解決問題具有共通性，再者，由證據1說明書第5頁第3至14行及證據8說明書第0058至0065段內容可知，證據1、8均係在絕緣膜上形成電路圖案，以作為封裝用之軟性電路基板，電路基板結構之功能作用相同，具有功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即有動機將證據1之軟性電路板製程所使用的聚醯亞胺基板，參照證據8第2(g)圖所示將表面變質層（相當於系爭專利之混合層）去除至僅具有聚醯亞胺之深度為止的形狀，以解決線路基板之絕緣可靠性問題，且證據8已揭露形成側蝕槽之結構特徵，通常知識者能預期具有側蝕槽可供用以容置該接著劑，並達成提高該接著劑的附著力之功效，故參酌系爭專利申請時之通常知識1、2，證據1、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。由於證據1、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，則證據1、2、8之組合、證據1、5、8與通常知識2之組合或證據1、2、5、8之組合亦均足以證明系爭專利請求項2不具進步性。㈢證據1、4、8與通常知識1、2之組合、證據1、2、4、8之組合、證據1、4、5、8與通常知識2之組合、證據1、2、4、5、8之組合均足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性。參酌系爭專利申請時之通常知

識1、2，證據1、8之組合、證據1、2、8之組合、證據1、5、8與通常知識2之組合或證據1、2、5、8之組合均足以證明系爭專利請求項2不具進步性，證據4復已揭露系爭專利請求項3至5之附屬技術特徵，業如前述。依證據1說明書第5頁第3至5行證據4摘要及證據8說明書第0001段內容所示，證據1、4、8均屬於半導體封裝用軟性電路板之技術領域，具有技術領域之關聯性，依證據1說明書第6頁第12至13行、證據4說明書第24頁第14至17行及證據8說明書第0031段內容所示，證據1、4、8均係為解決微細線路基板之絕緣可靠性問題，所欲解決問題具有共通性。再者，由證據1說明書第5頁第3至14行、證據4說明書第13至31頁及證據8說明書第0058至0065段可知，證據1、4、8均係在絕緣膜上形成電路圖案，以作為封裝用之軟性電路基板，電路基板結構之功能作用相同，具有功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即有動機將證據1之軟性電路板製程所使用的聚醯亞胺基板，參照證據8第2(g)圖所示將表面變質層（相當於系爭專利之混合層）去除至僅具有聚醯亞胺之深度為止的形狀，以解決線路基板之絕緣可靠性問題，並依證據4教示在配線圖案形成電鍍層之前將鄰接之配線圖案擴大及形成連結層，而輕易完成系爭專利請求項3至5之發明，故參酌系爭專利申請時之通常知識1、2，證據1、4、8之組合足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性。由於證據1、4、8之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性，則證據1、2、4、8之組合、證據1、4、5、8與通常知識2之組合、證據1、2、4、5、8之組合均足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性。㈣證據1、8與通常知識1、2之組合、證據1、2、8之組合、證據1、6、8與通常知識2之組合或證據1、2、6、8之組合足以證明系爭專利請求項11不具進步性。證據1、8均屬於半導體封裝用軟性電路板之技術領域，具有技術領域之關聯性，且證據1、8均係為解決微細線路基板之絕緣可靠性問題，所欲解決問題具有共通性，再者，證據1、8均係在絕

緣膜上形成電路圖案，以作為封裝用之軟性電路基板，電路基板結構之功能作用相同，具有功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即有動機將證據1之軟性電路板製程所使用的聚醯亞胺基板，參照證據8第2(g)圖所示將表面變質層（相當於系爭專利之混合層）去除至僅具有聚醯亞胺之深度為止的形狀，以解決線路基板之絕緣可靠性問題，且證據8已揭露形成側蝕槽之結構特徵，通常知識者能預期具有側蝕槽可供用以容置該接著劑，並達成提高該接著劑的附著力之功效，故參酌系爭專利申請時之通常知識2，證據1、8之組合足以證明系爭專利請求項11不具進步性。由於證據1、8之組合足以證明系爭專利請求項11不具進步性，則證據1、2、8之組合、證據1、6、8與通常知識2之組合或證據1、2、6、8之組合亦均足以證明系爭專利請求項11不具進步性。㈤系爭專利請求項12依附於請求項11，並界定「其中於蝕刻該些線路後，形成一連結層於各該線路，蝕刻後的各該線路具有一第三外環面及一頂面，該連結層覆蓋該第三外環面及該頂面，且該連結層接觸該第一承載部之該表面，以使各該線路被包覆於該第一承載部與該連結層所構成的空間中」之附屬技術特徵，系爭專利請求項13依附於請求項12，並界定「其中覆蓋該第三外環面的該連結層具有一第四外環面，該第四外環面與該縱向延伸線之間具有一第二水平距離」之附屬技術特徵。查系爭專利請求項12、13之附屬技術特徵與系爭專利請求項4、5之附屬技術特徵大致相同，而證據4已揭露系爭專利請求項4、5之附屬技術特徵，且證據1、8之組合足以證明系爭專利請求項11不具進步性，業如前述，證據1、4、8均屬於半導體封裝用軟性電路板之技術領域，具有技術領域之關聯性，證據1、4、8均係為解決微細線路基板之絕緣可靠性問題，所欲解決問題具有共通性，再者，證據1、4、8均係在絕緣膜上形成電路圖案，以作為封裝用之軟性電路基板，電路基板結構之功能作用相同，具有功能或作用之共通性，故該發明所屬技術領域中具

有通常知識者，即有動機將證據1之軟性電路板製程所使用的聚醯亞胺基板，參照證據8第2(g)圖所示將表面變質層（相當於系爭專利之混合層）去除至僅具有聚醯亞胺之深度為止的形狀，以解決線路基板之絕緣可靠性問題，並依證據4教示形成連結層，而輕易完成系爭專利請求項12、13之發明，故參酌系爭專利申請時之通常知識2，證據1、4、8之組合足以證明系爭專利請求項12、13不具進步性。由於證據1、4、8之組合足以證明系爭專利請求項12、13不具進步性，則證據1、2、4、8之組合、證據1、4、6、8與通常知識2之組合、證據1、2、4、6、8之組合亦均足以證明系爭專利請求項12、13不具進步性等語，為其論據。

四、本院經核原判決並無違誤。茲就上訴理由再予補充論述如下：

㈠本件上訴人碩邦公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即智慧局一致，本件應併列智慧局為上訴人。

㈡按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利係於105年3月17日申請，於106年6月13日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為核准時專利法第21條及第22條第1項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得專利，復為同法第22條第2項所明定。對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發

人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

㈢系爭專利之線路基板圖案化製程，於圖案化底板時，移除顯露的混合層，避免混合層吸附雜質而影響接著劑與線路基板之間的接合強度，而降低封裝構造良率。此外，另藉由等向性蝕刻所產生的側蝕槽S用以容置接著劑，進一步提高接著劑的附著力。系爭專利申請專利範圍共計15項，其中請求項1及10為獨立項，其餘均為附屬項，其中請求項2至9為依附請求項1之附屬項，請求項11至15為依附請求項10之附屬項。本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，就證據1、8與通常知識1、2之組合、證據1、2、8之組合、證據1、5、8與通常知識2之組合或證據1、2、5、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，證據1、4、8與通常知識1、2之組合、證據1、2、4、8之組合、證據1、4、5、8與通常知識2之組合、證據1、2、4、5、8之組合足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性，證據1、8與通常知識1、2之組合、證據1、2、8之組合、證據1、6、8與通常知識2之組合或證據1、2、6、8之組合足以證明系爭專利請求項11不具進步性，證據1、4、8與通常知識1、2之組合、證據1、2、4、8之組合、證據1、4、6、8與通常知識2之組合、證據1、2、4、6、8之組合足以證明系爭專利請求項12至13不具進步性，至其他證據組合均不足以證明系爭專利請求項2至7、11至15不具進步性等情，業據原審論述詳明，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背，而有判決違背法令之情形。

㈣依證據1第2圖(c)、(d)及說明書第5頁第22至23行、第6頁第9至13行、第17至20行記載內容所示，證據1揭露於聚醯亞胺膜1形成金屬化層3之際，產生表面變質層2，在溶解電路圖案外周的金屬化層3後，因露出電路圖案間的聚醯亞胺膜1表面係殘留含有原為金屬化層之金屬成分的表面變質層2等情，為原審依調查證據之辯論結果所認定之事實，原判決因

認：即以強力蝕刻液將聚醯亞胺膜1表面含有金屬成分的表面變質層2厚厚地去除，使得經蝕刻之聚醯亞胺膜1已經不具有表面變質層2，而顯露為原始狀態之聚醯亞胺膜1，即相當於系爭專利請求項2「圖案化底板具有一未活化層」之技術特徵等情，並無不合。可知，原判決據此認定證據1中所顯露之「原始狀態之聚醯亞胺膜1」即為經蝕刻而不具有表面變質層之聚醯亞胺膜。而上訴人所指「沒有去除電路外周部的金屬化層的原始狀態」係關於證據1圖2(b)之記載內容，與證據1第2圖(c)、(d)無關。上訴意旨以：證據1說明書中僅有一處提及「原始狀態」，證據1中僅有原始狀態之金屬化層，原判決在解釋證據1時，自應以證據1記載之內容為準，且圖2之製造步驟為不可分的一系列流程，圖2(b)之說明乃圖2(c)、(d)的前提基礎，當可作為證據1對原始狀態之解釋及定義云云，並無可採。

㈤所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言。承前關於「即以強力蝕刻液將聚醯亞胺膜1表面含有金屬成分的表面變質層2厚厚地去除，使得經蝕刻之聚醯亞胺膜1已經不具有表面變質層2，而顯露為原始狀態之聚醯亞胺膜1」部分，原判決認相當於系爭專利請求項2「圖案化底板具有一未活化層」之技術特徵。可知原判決係基於證據1未揭示對聚醯亞胺膜1進行活化處理，因此原始狀態之聚醯亞胺膜1相對於經過活化處理之聚醯亞胺膜，即屬於未活化狀態，而與系爭專利之未活化層實質相同而可對應。原審再比對證據1與系爭專利請求項2之差異後，論明：證據1雖揭露於聚醯亞胺膜形成金屬化層之際，在產生聚醯亞胺膜之表面上造成表面變質層2，惟證據1並未直接揭露聚醯亞胺底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層之技術特徵，故亦未直接揭露「部份的該結合層嵌入該活化層中，使得嵌有該結合層的該活化層形成為一混合層」及「該第二槽顯露該混合層……移除被該些第二槽顯露的該混合層，使位於該些第一承載部下方的該混合層形成複數個第

二承載部」之技術特徵等情。可知原判決係認由於證據1未揭示活化處理，故證據1並未同時揭露「經活化處理」形成之「活化層」及「未活化層」，未經活化處理之聚醯亞胺膜，本質上即為未活化層，因此原判決僅認為證據1之聚醯亞胺膜可對應系爭專利之「未活化層」，而與活化層或混合層相關之技術特徵，原判決則認定證據1未直接揭露，並無理由矛盾之違背法令情形 。上訴意旨以：原判決認定證據1已具體對應系爭專利「顯露未活化層」之技術特徵。在審酌系爭專利「底板具有活化層及未活化層」特徵時，又稱證據1未直接揭露。原判決對證據1是否揭露系爭專利「顯露未活化層」之特徵，於不同段落為相反之認定，顯有理由矛盾之違背法令云云，委無可採。

㈥原判決依證據8說明書第0001段、第0031段、第0058至0065段記載之內容，認證據8揭露為得到絕緣可靠性，去除金屬擴散層至僅具有聚醯亞胺之深度為止，而去除金屬擴散層之聚醯亞胺薄膜僅剩下原始聚醯亞胺本身，該剩下之聚醯亞胺薄膜即對應於系爭專利請求項2之「顯露未活化層」之技術特徵等情，核與卷內證據資料相符，無違論理法則及經驗法則。可知，原判決係基於證據8未揭示對聚醯亞胺進行活化處理，因此「剩下原始聚醯亞胺本身」因未經過活化處理，即屬於未活化狀態，而可對應系爭專利請求項2之「未活化層」。又原判決參酌證據1及證據11後，論明：就證據1所揭露以聚醯亞胺膜上形成鎳鉻合金的金屬化層並在其上以鍍銅形成銅箔層構成之電路圖案之製造方法，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，通常即會先活化處理聚醯亞胺膜之一表面，以提高聚醯亞胺膜與鎳鉻金屬化層間之結合力，而相當於系爭專利請求項2「底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層」之技術特徵。再參照證據8之揭示，將證據1之表面變質層（相當於系爭專利之混合層）去除至僅具有聚醯亞胺之深度為止（即顯露未活化層），以解決線路基板之絕緣可靠性問題等情，已論述其認定之依據及得心證之

理由，於法並無不合，尚無判決違背法令情事。上訴人碩邦公司主張證據8根本未揭露底板經活化處理而形成活化層及未活化層此一前提，原判決認定證據8已揭露系爭專利「顯露未活化層」之特徵，與證據8之內容不符，有裁判未依調查證據結果之不適用法規違背法令。原判決所稱「原始狀態」的聚醯亞胺膜，或稱「呈現原本之狀態」的聚醯亞胺膜，皆缺乏具體內容。原判決引用證據8，謂去除金屬擴散層之聚醯亞胺薄膜僅剩下「原始聚醯亞胺」本身，無事實基礎，違背論理法則云云，無非以其一己主觀之見解，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當或違背法則，均非可採。

㈦上訴人碩邦公司另主張：原判決依證據1中「電路密著性」一詞認定其隱含具有電路密著性之結構或組成。姑不論何謂「具有電路密著性之結構或組成」，依證據1中關於「電路密著性」的記載，係指在電路圖案表面施行金屬鍍覆時，鍍液滲入電路圖案下側被溶解的絕緣膜(即聚醯亞胺膜)與電路圖案之間所造成的問題，故使表面變質層從電路圖案的下側外周部以5微米以下的寬度剩餘殘留著…證據1並未在聚醯亞胺膜和電路圖案間隱含任何結構或組成，判決理由與證據1存在明顯歧異，原判決參酌通常知識2認定證據1的底板表面隱含活化層，違反論理法則，有不適用法規之違背法令云云。但查，依證據1第5頁第10至14行之記載(原判決第44頁第21至26行)及證據11內容所示(原判決第45頁第1至7行)，原判決論明：所述「電路密著性」即隱含聚醯亞胺膜和2層材料之電路圖案間具有電路密著性之結構或組成，在線路基板圖案化製程中，通常須先對聚醯亞胺底板進行活化處理，以增加金屬及聚醯亞胺底板間的接著，確係屬系爭專利申請時之通常知識。況系爭專利自承之先前技術亦記載「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路」。因此，就證據1所揭露以聚醯亞胺膜上形成鎳鉻合金的金屬化層並在其上以鍍銅形成銅箔層構

成之電路圖案之製造方法，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，通常即會先活化處理聚醯亞胺膜之一表面，以提高聚醯亞胺膜與鎳鉻金屬化層間之結合力，而相當於系爭專利請求項2「底板經由一活化處理而形成一活化層及一未活化層」之技術特徵等情，並無違反論理法則及經驗法則，亦無不適用法規之違法。從而，原判決僅在說明聚醯亞胺膜和2層材料之電路圖案間具電路密著性之需求，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者在依據通常知識2或證據11，自會對證據1之聚醯亞胺膜進行活化處理，以提高聚醯亞胺膜與鎳鉻金屬化層間之結合力，確保電路密著性，並無上訴人頎邦公司所指以證據11及系爭專利為佐證而對證據1進行解釋，進而認定證據1雖未直接揭露但隱含經活化處理後的活化層之情事。故上訴論旨，並非可採。

㈧再按專利審查基準僅規定教科書或工具書內所載之資訊即可認定為該所屬技術領域之一般知識，蓋因教科書或工具書為通常知識者過往學習使用之書籍，無須花費相當精力檢索，隨時可查詢到之資訊，可作為代表所屬技術領域一般知識範圍。查上訴人頎邦公司於舉發階段另主張系爭專利說明書所載先前技術，即「在習知的線路基板製程中，會先活化處理一底板的一表面，以利於後續製程中形成線路」係屬申請時之通常知識2。嗣經原審行使闡明權後，上訴人頎邦公司另提出證據11之西元2007年4月台灣電路板協會公開發行之「軟性電路板材料全書」參考書以為佐證。原判決係依證據11可佐證「在線路基板圖案化製程中，先對聚醯亞胺（PI）底板進行活化前處理」，屬於系爭專利申請時之通常知識，並非認定「濺鍍銅層製程」屬於通常知識，且專利審查基準並未規定通常知識須為我國通常知識者所能實施。故上訴人頎邦公司主張：證據11於西元2007年公開時，所揭示之內容僅能為具備高度知識之專業技能者在國外實施，國內業者必須透過國外專家進行專有知識(know-how)的技術移轉始能實施。證據11應為先前技術，難認屬於審查基準所稱「申請時

之通常知識」。證據11所記載活化處理並非系爭專利申請時之通常知識。原判決認定證據11為通常知識2完全沒有論理基礎，除了證據11沒有其他證據，逕認系爭專利說明書「先前技術」所載內容自承通常知識2，違背論理法則，有不適用行政訴訟法第189條第1項前段之違法云云，均無可採。

㈨末查，由證據8第2(g) 圖所示，剩下的金屬擴散層3作為承載銅鍍層41之第二承載部，基底金屬化層11及銅金屬化層22作為承載銅鍍層41之第一承載部，其中第一承載部具有第一外環面，第二承載部具有第二外環面，第二外環面相較於第一外環面之縱向延伸線之間具有一水平距離，更位於內側，形成有側蝕槽，該側蝕槽位於基底金屬化層11下方且連通有槽，即對應於系爭專利請求項2之附屬技術特徵等情，業據原審論明，並無不合。又原判決所引證據8第2(g)圖為另一實施例態樣(金屬擴散層3較基底金屬化層11內縮)，可對應證據8請求項6、9及說明書第[0021]至 [0023]、[0041]段之記載。而本院103年度判字第126號判決係關於由圖式推測之內容，例如從圖式直接量測之尺寸，常因影印之縮放造成誤差，如厚度的量測，不宜直接引用，而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，則可做為參考，核與本件案情有別，尚難比附援引。故上訴人頎邦公司主張：證據8說明書中並無隻字片語述及基底金屬化層11可突出於金屬擴散層3而形成有側蝕槽，原判決自行由證據8第2(g)圖推測之內容作為判斷依據，而非本於證據8說明書明確揭示的內容做為其判決理由，與本院上開判決意旨不符，有不適用法規之違法。依證據8請求項1、4及說明書第[0017]至[0019]段之記載，金屬擴散層3必先突出於基底金屬化層11，而基底金屬化層11可再突出於同金屬化層22，證據8第2(g)圖所繪示之內容與其請求項與說明書記載矛盾，顯然有誤云云，均無可採。

㈩綜上所述，原判決並無上訴人頎邦公司所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，

應予駁回。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟法第253條第1項第2款所明定。本件縱涉及專門知識，且影響上訴人頎邦公司之權利，然當事人就相關專門知識均已具狀說明，故本件事證已明，且經審酌本件訴訟之情節，本院認無行言詞辯論之必要，併此敘明。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　16　　日

最高行政法院第三庭

審判長法　官　胡　方　新

法　官　蕭　惠　芳

法　官　曹　瑞　卿

法　官　梁　哲　瑋

法　官　林　惠　瑜

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　16　　日

書記官　林　郁　芳